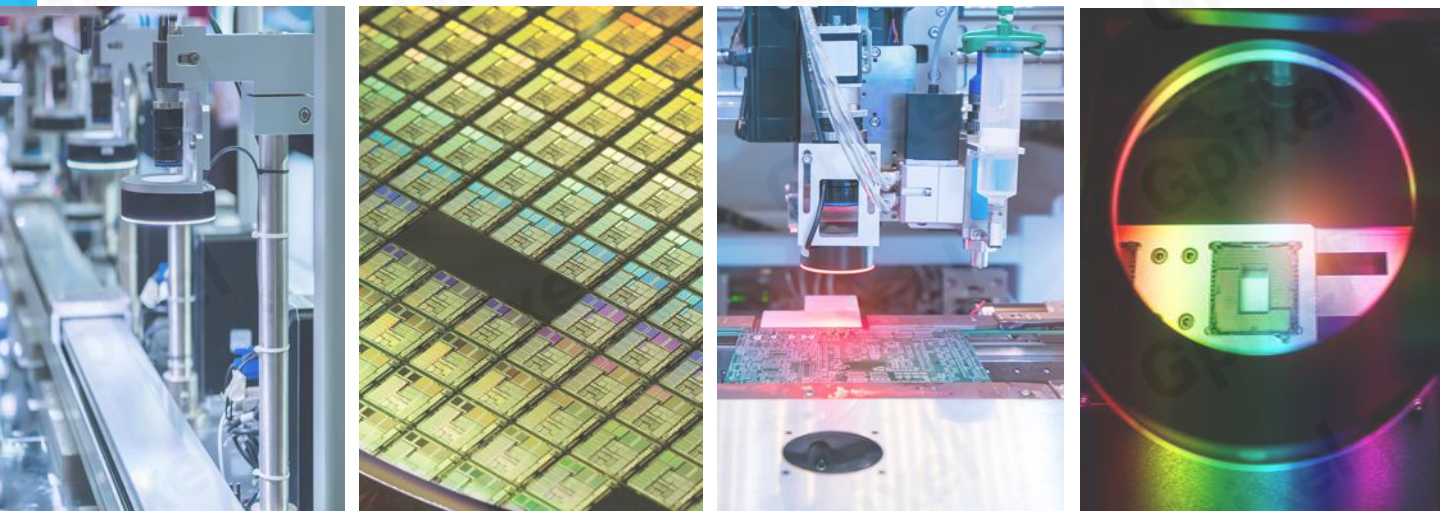


GLT5009BSI



9K背照式TDI CMOS图像传感器

GLT5009BSI是一款背照式电荷域时间延时积分(TDI)CMOS图像传感器。GLT5009BSI像素尺寸为 $5\ \mu\text{m}$,横向分辨率为9072,级数达到256级。结合先进的背照式工艺,使其具有极高的灵敏度,以满足在高速、弱光环境下的检测需求。GLT5009BSI具有 $16\ \text{ke}^-$ 的满阱容量以及小于 $8\ \text{e}^-$ 的读出噪声,动态范围可达68.7 dB。芯片集成两个谱段,分别为256级和32级,在双谱段工作模式下,可进行HDR合成,动态范围可达77.5 dB。该芯片采用84对Sub-LVDS输出,最大数据速度可达74.304 Gbps。芯片支持多种工作模式,10 bit输出时最高行频可达608 kHz,12 bit输出时最高行频为300 kHz。GLT5009BSI采用了269针 μPGA 陶瓷封装,同时片上集成时序生成器、LVDS通道合并、双向扫描等功能,使得用户的相机设计更加简单。



产品特性

- 双感光谱段
- 像素尺寸: $5\ \mu\text{m}$
- 背照式、TDI
- 高灵敏度
- 双谱段HDR
- 可调模拟增益
- 10/12 bit ADC
- 片上温度传感器、SPI控制

应用领域

- 平板显示器检测
- PCB检测
- 晶圆检测
- 荧光显微成像
- 医疗

产品指标

分辨率	P1: 072x256Effective 9288x256Readable P2: 9072x32 ffective 9288x32Readable	感光面积	P1: 45.36mmx1.28mm P2: 5.36mmx0.16mm
像素尺寸	5 um x 5 um	光学暗像素	100(left) + 100(right)
输入时钟频率	35 – 70 MHz 默认36 MHz	最高行频	608 kHz @ 10bit 300 kHz @ 12bit
满阱容量	15.8 ke ⁻ @ 10bit 19.2 ke ⁻ @ 12bit	读出噪声	11.4 e ⁻ @ 10bit 7.2 e ⁻ @ 12bit
动态范围	63.6 dB @ 10bit 68.7 dB @ 12bit	电荷转移	≥ 0.99993
暗电流	4 ke ⁻ /s/pixel	PRNU	0.6% @ 128 stage
最大数据率	74.304 Gbps	供电电压	5V 模拟 1.8V 数字 /ADC
输出接口	84 x Sub-LVDS 2 x Sub-LVDS@OB 3 x Sub-LVDS@DDR	通道合并	84/42/21/12/6/3
功耗	<5.5 W @ 300 kHz	彩色	黑白

订购信息

产品编码

GLT5009BSI-BBM-NUN- BR1 黑白, 无微透镜, 269 pins micro-PGA陶瓷封装, 可拆卸双面有抗反射镀膜的D263®T eco玻璃盖板, 1级品。	GLT5009BSI-BBM-NUN- BU1 黑白, 无微透镜, 269 pins micro-PGA陶瓷封装, 密封双面有抗反射镀膜的D263®T eco玻璃盖板, 1级品。
---	--

评估板

EVA-5009B-CTC, USB 接口, PCB 板

联系方式

长光辰芯 (总部)

地址: 吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号, 光电信息产业园一期5号办公楼
电话: +86-0431-85077785

长光辰芯 (杭州子公司)

地址: 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话: +86-571-87718606-888

长光辰芯 (大连子公司)

地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话: +86-0411-39937666



更多联系方式